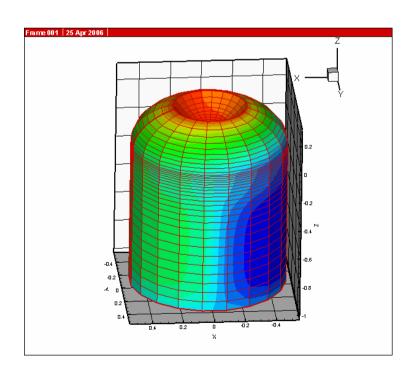
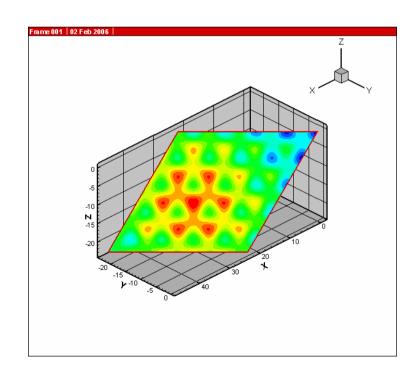
STMシミュレータのご提案

Advanced Algorithm & Systems

作業内容

- 一般曲線座標への対応
- 計算の並列化
- マクロ静電場計算とミクロ電子状態計算の連結
- ・ (電流項の追加(非平衡計算への拡張))





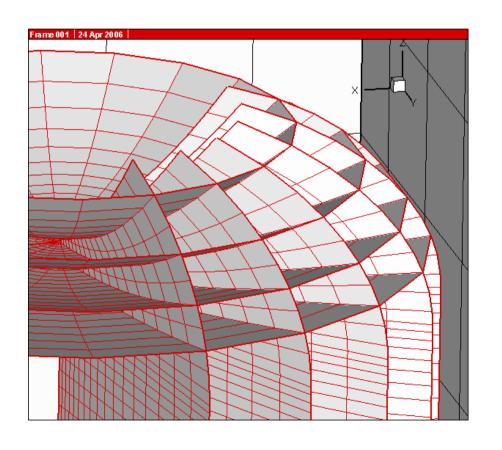
1. 一般曲線座標への対応

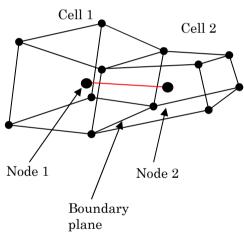
昨年まではグリッドの座標に局所直交性を仮定していた。これを任意の座標を取り扱えるように 拡張する。

(一部有限要素的手法を取り入れる。)

局所直交座標 → 一般曲線座標

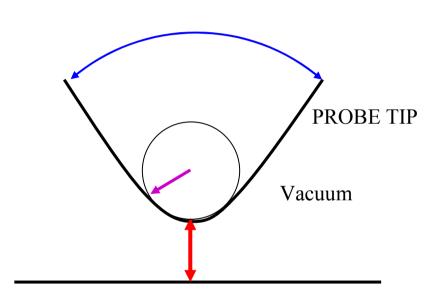
1.2 グリッドの柔軟な指定





非直交

1.3 Tip曲率、開き角、Tip-Sample間距離の独立指定

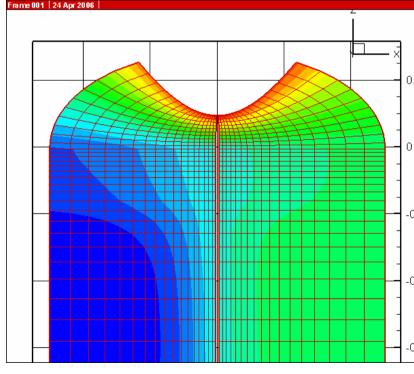


SEMICONDUCTOR SAMPLE(Continuum)

Open angle

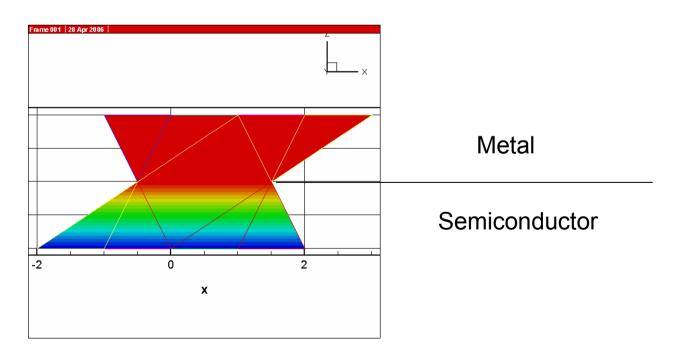
Curvature

Distance



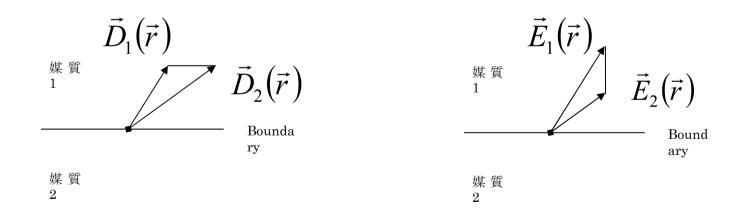
1.4 数値スキーム

- ・ セル境界の \vec{D} の垂直成分を空間一次精度で求める。(フラックス)
- 各cellにおける体積積分を上記フラックスから計算する。



1.5 フラックスの求め方

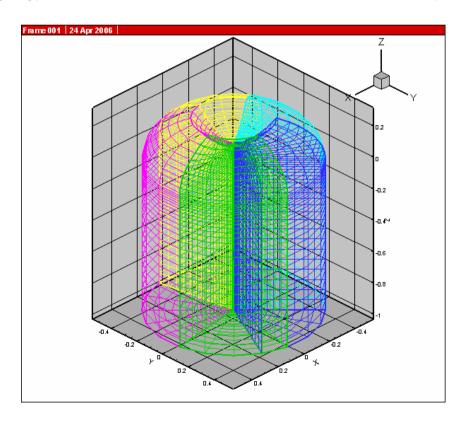
- 各セル境界において境界条件を満たすように電圧 を空間1次精度で内挿する。
- 上で求めた電圧からフラックスを計算する。



上記手続きは一意でない

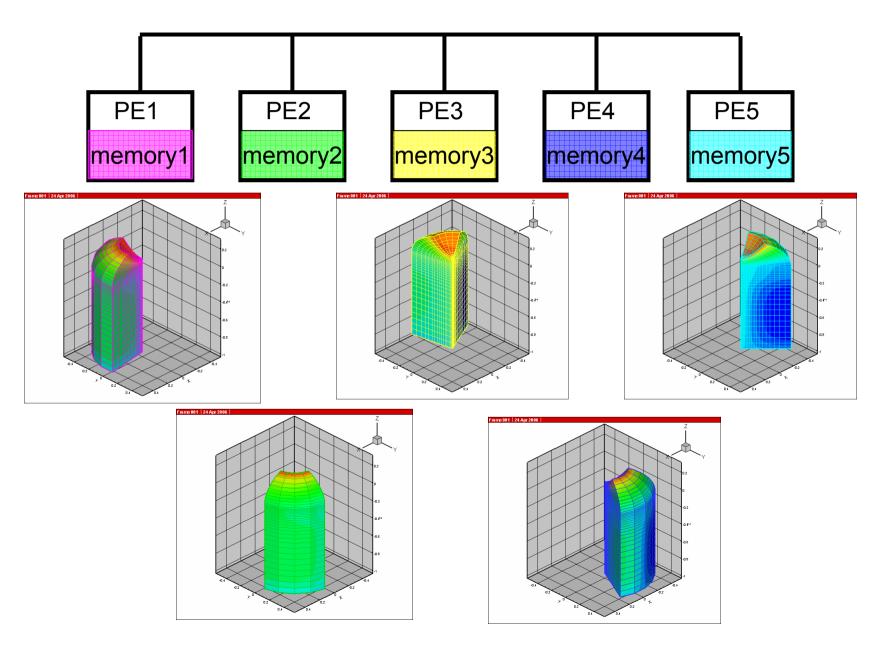
2. 計算の並列化

- ・ 計算の大規模化
- ・ 計算の高速化
- ・ 複数ブロックを用いるMulti-Blockに対応。1.とあわせてより柔軟なグリッド形状に対応可能



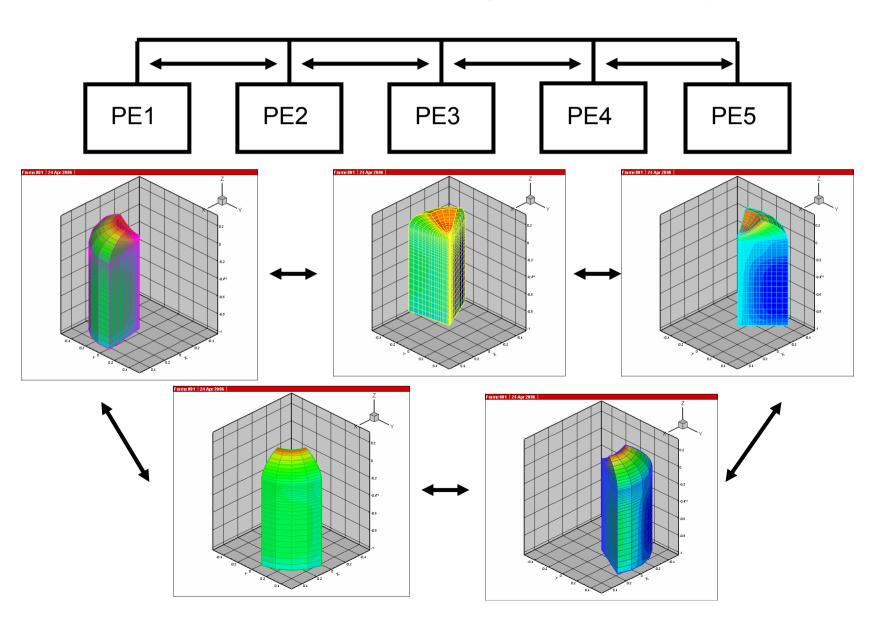
2.1 計算の大規模化(完全なメモリ分散)

完全にメモリ分散することにより1PEあたりのメモリ負荷を最小限に抑える。

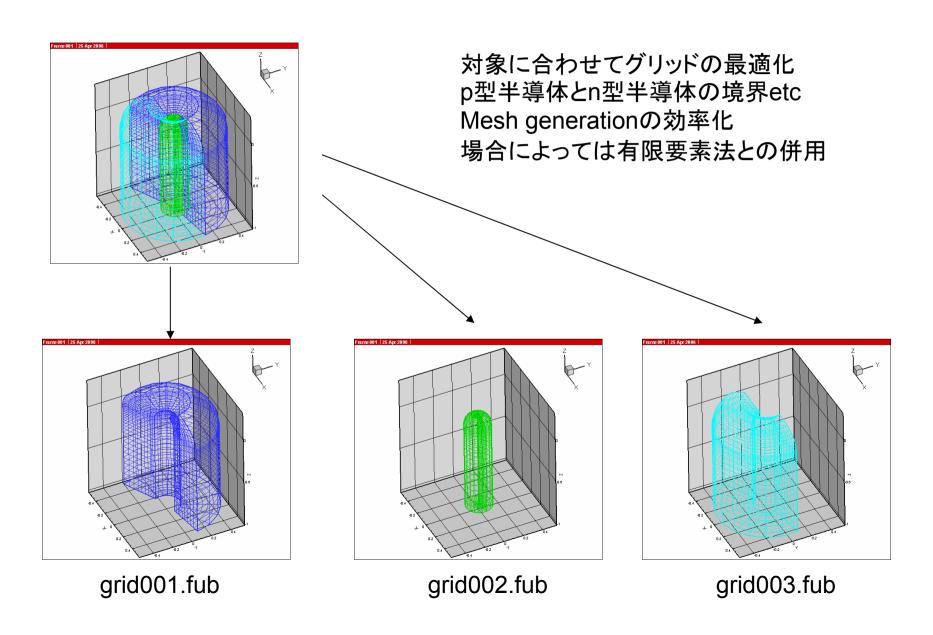


2.2 計算の高速化(効率的なアルゴリズム)

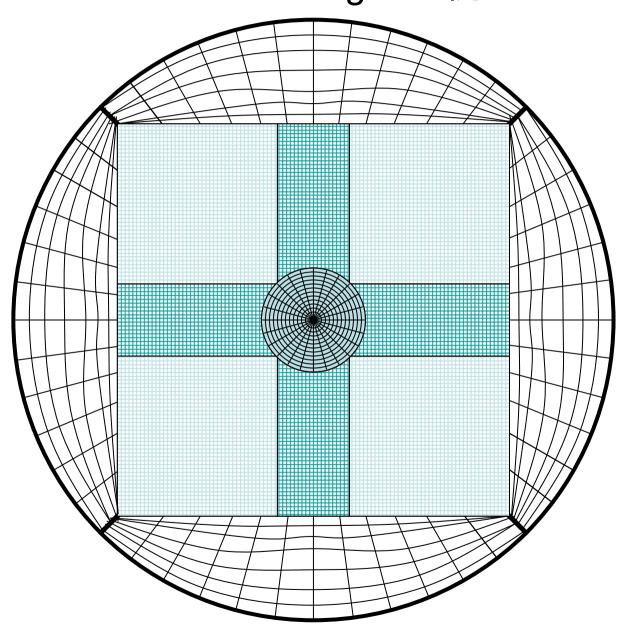
必要最小限のデータのやり取りと最小の計算スケジュールによる高速化の実現

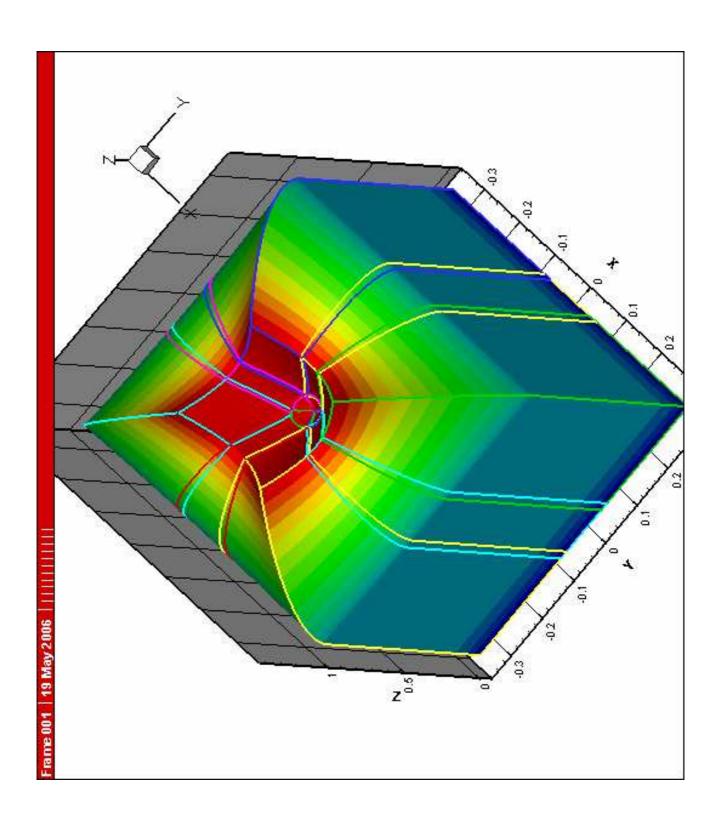


2.3 Multi-gridによるグリッドの柔軟化



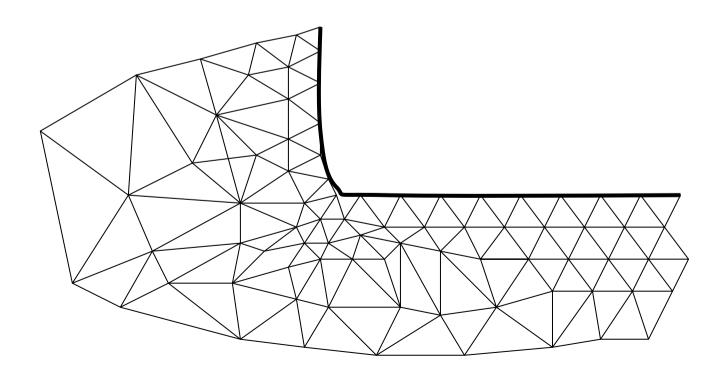
2.3.1 Multi-gridの例





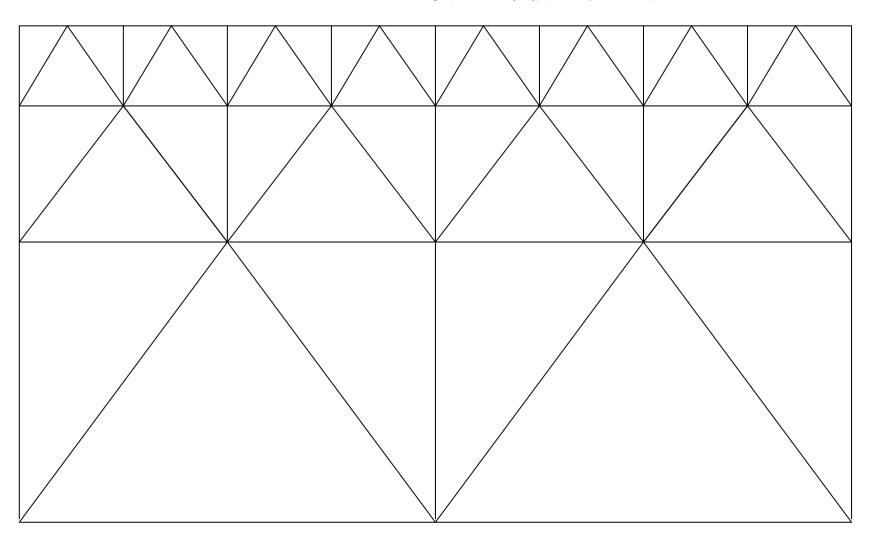
2.3.2 Finite element method

- 格子の自動生成
- 並列計算
- 場合によっては広範に導入する



2.3.3 Finite element methodの利点

スケールのresolutionの変化に柔軟に対応できる



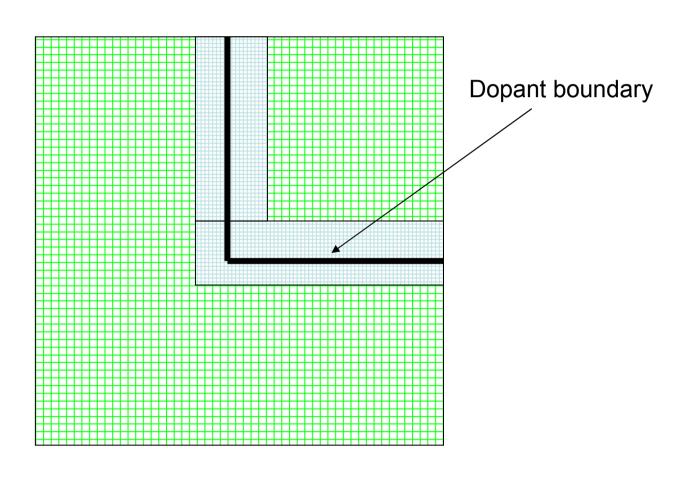
2.3.4 Multi-gridでの対応 (Adapted Mesh Refinement(AMR))

規則IJK格子でResolutionをコントロールするのは比較的困難

•					
	•)			

2.3.5 Adaptive mesh refinementの例

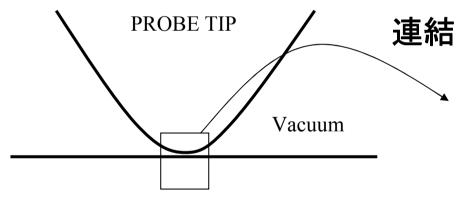
以下の形でドーパントのプロファイルに対応する



3. マクロ静電場計算とミクロ電子状態計算の連結

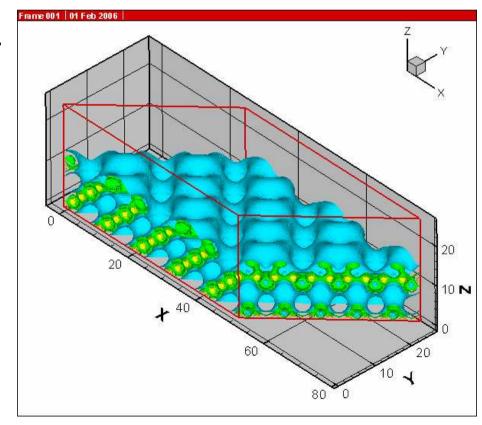
効率のよいインターフェースを開発する。

Microscopic calculation



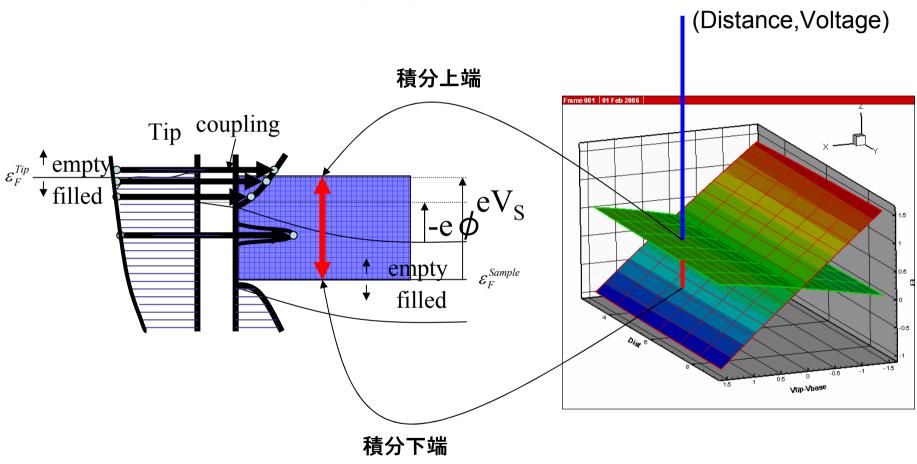
Macroscopic calculation(Continuum)

表面誘導電位 の計算



3.1 転送データ

積分領域の決定



 $-e\phi$ eV_s 等をさまざまなジェオメトリでまとめてミクロ計算へ送る

4. 電流項の追加(非平衡計算への拡張)

- 電極を介した正味の加電圧を加えることが出来る。
- 半導体を絶縁体で分離できる。

主な目的は2番目のものなので場合によってはよりよい方法で実装する

数値計算のスキーム

Semiconductor devices :
a numerical approachによるfinite difference
に基礎を置く。